

129НТ1Г-1, Микросхема интегральная

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#)

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#)

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#)

129НТ1Г микросхемы полупроводниковой:

129НТ1Г-1 — интегральная микросхема артикул согласно ГОСТ микросхемы бескорпусные используются в радиоэлектронной аппаратуре в широком спектре применения и предназначена микросхема интегральная бескорпусная для работы в качестве базовой схемы дифференциального усилителя. Применяется в качестве элементов составных интегральных чипов, микрочипов, блоков и аппаратуры, создающих герметичность и защищенность диодов СВЧ от влияния высокого уровня влажности, солей пыли, плесени, изморози и водяных осадков и перепадов давления. Модель прибора указывается на индивидуальной таре. Климатическое исполнение микросхем УХЛ и соответствует техническим условиям ТУ. Микросхема 2) соответствует техническим условиям 3.456.013ТУ.

Ссылки на технические материалы

ссылки на 129НТ1Г-1 дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	параметры	предельные параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Схема расположения выводов



Назначение выводов

таблица 129НТ1Г-1 назначения выводов:

Номер вывода	Назначение вывода	Номер вывода	Назначение вывода
1	Коллектор VT2	4	Коллектор VT1
2	База VT2	5	База VT1
3	Эмиттер VT2	6	Эмиттер VT1

Основные электрические параметры при t=25+-10 градусов Цельсия

таблица основные 129НТ1Г-1 электро параметры:

	Буквенное	Тип	Норма

Название характеристики, режим и единица замера	обозначение	микросхем	не менее	не более
Обратный ток коллектора, нА (Ucb=20V)	J CBO	А-И	-	20
Обратный ток эмиттера, нА (Ube=4V)	J EBO	А-И	-	50
Начальный ток коллектора, нА (Uce=15V, Rb=10 ⁴)	J CBS	А-И	-	50
Ток утечки между транзисторами, нА (Ut1,t2=25V)	J t1, t20	А-И	-	10
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте (Ucb=5V, Je=3mA, f=10 ⁸ Hz)	/h21e/	А, Г, Д, Е, Ж, И	2,5	-
		Б	3,5	-
		В	4,5	-
Емкость коллекторного перехода, pF (Ucb=5V, f=10 ⁷ Hz)	Cc	А-И	-	3
Емкость эмиттерного перехода, pF (Ube=1V, f=10 ⁷ Hz)	Cc	А-И	-	4
Статический коэффициент прямой передачи тока в схеме с общим эмиттером в режиме большлго сигнала (Ucb=5V, f=50Hz, tu=2ms): Je=1mA	h21e	А, Г	30	90
		Б, Д	60	180
		Ж, И	40	160
		В, Е	80	-
Je=0.05mA				
Отношение статических коэффициентов в прямой передачи токов в схеме с общим эмиттером в режиме большлго сигнала (Ucb=5V, f=50Hz, tu=2ms): Je=1mA	h21e1/h21e2	А, Б, Ж	0,90	-
		Г, Д, И	0,80	-
		В	0,92	-
		Е	0,80	-
Je=0.05mA				
Прямое напряжение эмиттер-база, V (Ucb=5V, Je=1mA)	U EB	А-И	0.55	0.75
Модуль разности прямых напряжений эмиттер-база, mV (Ucb=5V, Je=1mA)	/Ueb1-Ueb2/	А, Б, В, Ж	-	3
		Г, Д, Е, И	-	10

Предельные 129НТ1Г-1 параметры

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадырь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.